

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成 19 年 6 月 14 日 (2007.6.14)

【公開番号】特開 2006-179791(P2006-179791A)
【公開日】平成 18 年 7 月 6 日 (2006.7.6)
【年通号数】公開・登録公報 2006-026
【出願番号】特願 2004-373405(P2004-373405)
【国際特許分類】

H 0 1 L 23/373 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/36 M

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 4 月 19 日 (2007.4.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 金属の間に前記第 1 金属よりも硬度の大きい第 2 金属を挟んだ積層構造の一部に凹部を形成し前記第 2 金属のない領域を設けた底板と、この底板の前記第 2 金属のない領域に配置した半導体素子とを具備したことを特徴とする半導体装置。

【請求項 2】

前記底板上に形成した金属製の側壁と、この側壁を貫通する金属リードと、前記側壁及び前記金属リードが接触しないように設けられる絶縁体とを設けたことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 3】

前記底板の積層構造は 2 つの第 1 金属の間に第 2 金属を挟んだ 3 層構造で、前記 2 つの第 1 金属は厚さが同じであることを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【請求項 4】

前記半導体素子を絶縁体で覆い、この絶縁体で覆った半導体素子と前記凹部との隙間に金属を充填したことを特徴とする請求項 1 に記載の半導体装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

本発明の半導体装置は、第 1 金属の間に前記第 1 金属よりも硬度の大きい第 2 金属を挟んだ積層構造の一部に凹部を形成し前記第 2 金属のない領域を設けた底板と、この底板の前記第 2 金属のない領域に配置した半導体素子とを具備したことを特徴とする。